

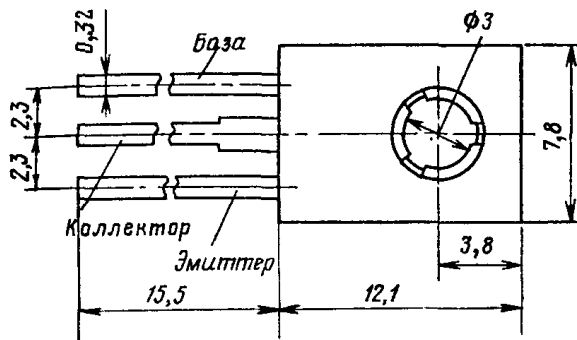
КТ626А, КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* высоко-частотные универсальные

Предназначены для работы в усилителях коротковолнового диапазона и переключающих схемах.

Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе.

Масса транзистора не более 1,0 г.



Электрические параметры

Граничная частота при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА не менее.

КТ626Б	75	МГц
КТ626А, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	45	МГц

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 2$ В, $I_К = 0,15$ А:

КТ626А	40–250
КТ626Б	30–100
КТ626В	15–45
КТ626Г	15–60
КТ626Д	40–250

Обратный ток коллектора не более:

КТ626А при $U_{КБ} = 30$ В	10	мкА
КТ626Б, КТ626В при $U_{КБ} = 30$ В, КТ626Г, КТ626Д при $U_{КБ} = 20$ В	150	мкА

Обратный ток эмиттера * при $U_{ЭБ} = 4$ В не более:

КТ626А	10	мкА
КТ626Б, КТ626В, КТ626Г, КТ626Д	300	мкА

Постоянная времени цепи обратной связи * на $f = 5$ МГц, при $U_{КБ} = 10$ В, $I_Э = 30$ мА не более

500 пс

Емкость коллекторного перехода * при $U_{КБ} = 10$ В не более

150 пФ

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер КТ626А, КТ626Б при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,05$ и КТ626В, КТ626Г, КТ626Д при $I_К = 0,5$ А, $I_Б = 0,1$ А не более

1,0 В

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база.

КТ626А	45 В
КТ626Б	60 В
КТ626В	80 В
КТ626Г, КТ626Д	20 В

Постоянный ток коллектора 0,5 А

Импульсный ток коллектора 1,5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при $T_k \leq 333 \text{ К}$ 6,5 Вт

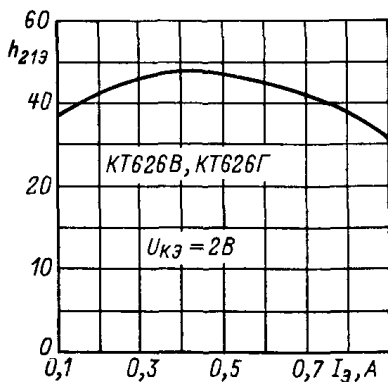
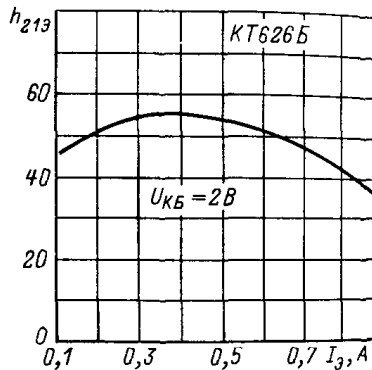
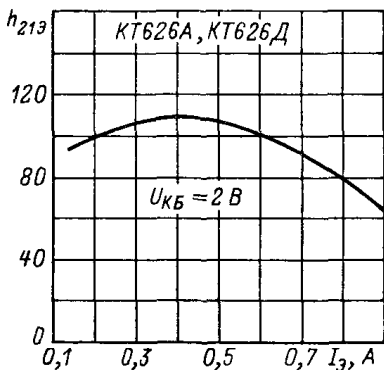
при $T_k = 358 \text{ К}$ 4 Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус 10 К/Вт

Температура перехода 398 К

Температура окружающей среды От 233 до $T_k = 333 \text{ К}$

Примечание. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5–2 мм.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Материал взят из источника: